

奈米中心 Dual E-GUN B 考核記錄表

學校系所:_____考試日期:_____學號:_____姓名:_____

一.筆試(100%，每題 5 分) **80 分以上才可進行實作考試**

1. 本機台使用之 CDA 氣體作用為_____及_____,PN2 作用為_____及再生。
2. 設備冷卻水最主要提供_____,_____兩個設備冷卻之用。
3. 本機台使用之石英振盪片(Crystal)為_____MHz，低於_____MHz 以下需更換。
4. 盛裝鍍料用坩堝依材料不同有區別,目前以使用哪_____,_____兩種坩堝為主。
5. 鍍鍋(Holder)以放置_____及_____尺寸晶片為主,如有其他尺寸或破片須以真空膠帶黏附於_____再放於鍍鍋上。
6. 抽真空後須待面板上_____,_____及離子真空計控制器_____,_____之燈號亮起及抽真空提醒聲響起後方可確認處於抽真空階段。
7. 檢查真空值時須達__Torr 以下，再按 L 鍵回一般的 scal 才可進行後續操作,鍍膜期間應避免再按 L 鍵查看，以免真空值變化過大造成異常 ALARM。
8. 鍍膜 Power supply,主電源開啟後,高電壓值顯示為_____KV。
9. 影響電子束操作電流大小的原因有_____,_____,新(舊)料等。

二.實作(100%) **考試及格分數為 80 分**

- _____1.操作前檢查作業:確認水、電、氣供應，紀錄簿注意事項，使用紀錄填寫及操作標示牌等事項。(10%)
- _____2.各項操作步驟
 - 破真空操作及注意事項(5%)
 - Gun Body 及腔體清潔細節重點(10%)
 - 坩鍋與鍍料放置及注意事項(5%)
 - Wafer 放置、Wafer Holder 更換及注意事項(10%)
 - 鍍膜製程參數設定(5%)
 - Jig Drive、Shutter、Local Control Box 操作與注意事項(12%)
 - Electric Beam power supply 開(關)機操作(5%)
 - 電子束加熱點控制與鍍料熔融狀態判斷(10%)
 - 功率、鍍率、膜厚等操作控制(10%)
 - 破腔取片時機(3%)
- _____3.實驗結束後復歸作為(10%)
- _____4.異常警報及狀況處置(5%)

考試時間:_____:____~_____:_____實作評分:_____考核員簽名:_____